



产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

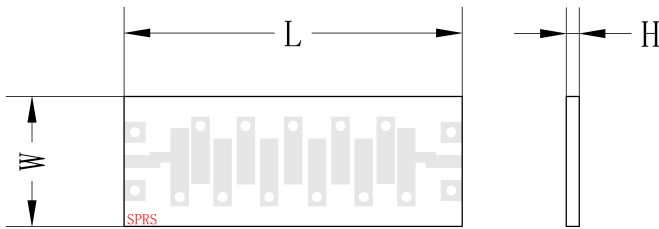
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.3	GHz
工作带宽	18.0-28.6	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	45@DC-15.6GHz	dBc
带外抑制	40@32.2-50.0GHz	dBc

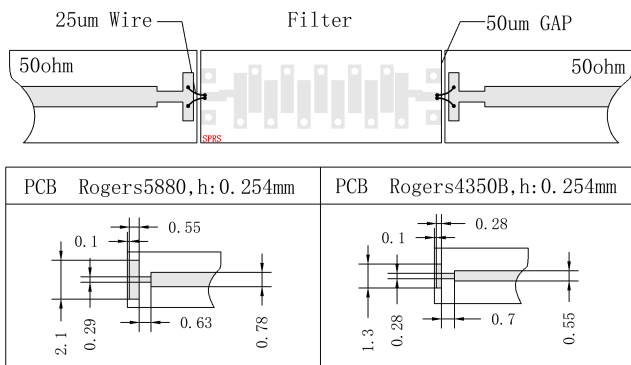
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	L: 6.0, W: 2.5, h: 0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



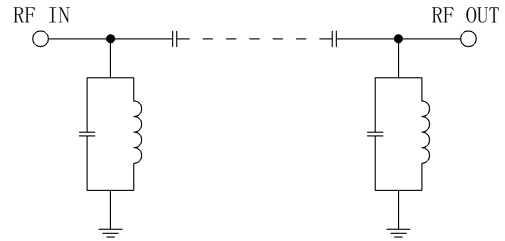
注意事项

- 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;
- 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm;
- 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;
- 由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

参考图



原理图



典型曲线

